

**Физика и техника полупроводников, 2018,  
том 52, выпуск 9**

**Спектроскопия, взаимодействие с излучениями**

Окулич Е.В., Окулич В.И., Тетельбаум Д.И.

**Расчет влияния плотности ионного тока и температуры на кинетику накопления точечных дефектов при облучении кремния легкими ионами**

967

Толкачева Е.А., Маркевич В.П., Мурин Л.И.

**Оптические свойства и механизм образования вакансионно-кислородных комплексов  $V_2O_2$  и  $V_3O_2$  в облученных кристаллах кремния**

973

**Поверхность, границы раздела, тонкие пленки**

Яфаров Р.К.

**Влияние высокодозной имплантации углерода на фазовый состав, морфологию и автоэмиссионные свойства кристаллов кремния**

980

Шкумбатюк П.С.

**Поверхностное дефектообразование в CdTe при воздействии излучения  $CO_2$ -лазера**

986

Ширяев А.А., Воротынцев В.М., Шоболов Е.Л.

**Эффект Пула--Френкеля и возможность его применения для прогнозирования радиационного накопления заряда в термическом диоксиде кремния**

990

Ситников А.В., Жилова О.В., Бабкина И.В., Макагонов В.А., Калинин Ю.Е., Ремизова О.И.

**Структура и электрические свойства пленок на основе оксида олова, легированных цирконием**

995

**Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления**

Стовпяга Е.Ю., Еуров Д.А., Курдюков Д.А., Смирнов А.Н., Яговкина М.А., Yakovlev D.R., Голубев В.Г.

**Матричный синтез монодисперсных сферических нанокompозитных частиц  $SiO_2/GaN:Eu^{3+}$**

1000

Орлов Л.К., Волкова Н.С., Ивина Н.Л., Орлов М.Л.

**Электрополевое поведение резонансных особенностей в туннельной составляющей фототока в гетероструктурах  $InAs(QD)/GaAs$**

1006

Кондратенко Т.С., Смирнов М.С., Овчинников О.В., Шабуня-Клячковская Е.В., Мацукович А.С., Звягин А.И., Винокур Я.А.

**Размерно-зависимые оптические свойства коллоидных квантовых точек CdS, пассивированных тиогликолевой кислотой**

1015

Иванов К.А., Губайдуллин А.Р., Калитеевский М.А.

**Квантование электромагнитного поля в трехмерных фотонных структурах на основе формализма матрицы рассеяния (S-квантование)**

1023

Смагина Ж.В., Зиновьев В.А., Кривякин Г.К., Родякина Е.Е., Кучинская П.А., Фомин Б.И., Яблонский А.Н., Степихова М.В., Новиков А.В., Двуреченский А.В.

**Исследование структурных и излучательных свойств  $Ge(Si)$  квантовых точек, упорядоченных на поверхности  $Si(001)$**

1028

Колодезный Е.С., Курочкин А.С., Рочас С.С., Бабичев А.В., Новиков И.И., Гладышев А.Г., Карачинский Л.Я., Савельев А.В., Егоров А.Ю., Денисов Д.В.

**Влияние легирования барьерных слоев на эффективность фотолюминесценции напряженных гетероструктур  $InGaAlAs/InGaAs/InP$**

1034

**Аморфные, стеклообразные, органические полупроводники**

Кастро Р.А., Грабко Г.И., Кононов А.А.

**Низкочастотная диэлектрическая релаксация в стеклообразной системе  $Ge_{28.5}Pb_{15}S_{56.5}$  с примесью железа**

1038

**Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники**

Середин П.В., Леньшин А.С., Федюкин А.В., Голощяпов Д.Л., Лукин А.Н., Арсентьев И.Н., Жаботинский А.В.

**Влияние режимов электрохимического травления на морфологию, структурные и оптические свойства пористого арсенида галлия**

1041

Орлецкий И.Г., Илащук М.И., Солован М.Н., Марьянчук П.Д., Парфенюк О.А., Майструк Э.В., Ничий С.В.

**Электрические свойства и энергетические параметры гетеропереходов  $n-FeS_2/p-Cd_{1-x}Zn_xTe$**

1049

Володин В.А., Rui Zhang, Кривякин Г.К., Антоненко А.Х., Stoffel M., Rinnert H., Vergnat M. <b>Формирование светоизлучающих в ИК-диапазоне нанокристаллов германия в пленках Ge:SiO<sub>2</sub></b>	1056
Саидов А.С., Лейдерман А.Ю., Усмонов Ш.Н., Амонов К.А. <b>Эффект инжекционного обеднения в p-Si-n-(Si<sub>2</sub>)<sub>1-x</sub>(ZnSe)<sub>x</sub> (0 ≤ x ≤ 0.01) гетероструктуре</b>	1066
Тепляков М.П., Кен О.С., Горячев Д.Н., Сресели О.М. <b>Транспорт и фоточувствительность в структурах: композитный слой из наночастиц кремния и золота на p-Si</b>	1071
<b>Углеродные системы</b>	
Рутьков Е.В., Галль Н.Р. <b>Интеркалирование молекул фуллерена C<sub>60</sub> под однослойный графен на карбиде молибдена</b>	1076
<b>Физика полупроводниковых приборов</b>	
Клочко Н.П., Копач В.Р., Хрипунов Г.С., Корсун В.Е., Любов В.Н., Жадан Д.О., Отченашко А.Н., Кириченко М.В., Хрипунов М.Г. <b>Гетероструктура для обращенного диода на основе электроосажденного в импульсном режиме наномассива оксида цинка и изготовленной методом SILAR пленки иодида меди</b>	1081
Куницына Е.В., Андреев И.А., Коновалов Г.Г., Иванов Э.В., Пивоварова А.А., Ильинская Н.Д., Яковлев Ю.П. <b>Фотодиоды для ближней инфракрасной области спектра на основе GaSb/GaAlAsSb-гетероструктур</b>	1094
Дубинов А.А., Алешкин В.Я., Морозов С.В. <b>Снижение порога генерации с помощью легирования в лазерах среднего инфракрасного диапазона на основе HgCdTe с квантовыми ямами HgTe</b>	1100
<b>Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур</b>	
Анисимов А.Н., Вольфсон А.А., Мохов Е.Н. <b>Спектры рамановского рассеяния толстых эпитаксиальных слоев GaN на SiC, полученных сублимационным сандвич-методом</b>	1104